



Comportement plastique cristallin et hétérogénéités de déformation dans les polycristaux

L. Vincent^a, L. Gélébart^a, R. Dakhlaoui^b, B. Marini^a

^a CEA Saclay, DEN, SRMA, 91191 Gif sur Yvette cedex

^b Grande Armée Conseil, 13 rue de Londres, 75009 Paris



Hétérogénéité de déformation dans les polycristaux

26 Novembre 2009



DMN/SRMA

Introduction - Contexte



Hétérogénéité de déformation dans les polycristaux 26 Novembre 2009



Hétérogénéité de déformation dans les polycristaux

26 Novembre 2009



PLAN



Localisation de la contrainte :

- . Expérimentale
- . Polycristalline
- . Eléments finis
- Loi de Comportement
- □ Résultats Analyse
- Conclusion Perspectives



DMN/SRMA

PLAN



□ Introduction – Contexte

Localisation de la contrainte :

- . Expérimentale
- . Polycristalline
- . Eléments finis
- Loi de Comportement
- □ Résultats Analyse
- Conclusion Perspectives



DEN/Saclay/Département des Matériaux pour le Nucléaire



Orientations correspondant à {X3}<X1>

- A : {001}<100> Plan de clivage perpendiculaire à la direction de traction, fschmid_{max}=0,47
- B : {110}<1-11> syst de glissement {110}<111> dans la direction de traction fs_{max} <0,32
- C : {11-2}<111> syst de glissement {112}<111> dans la direction de traction fs $_{max}<0,32$
- D : {-110}<112> plans de glissement {110},{112} colinéaire et perpendiculaire à la direction de traction
- E : {111}<-211> syst de glissement {112}<111> perpendiculaire à la direction de traction $fs_{max}=0,4$



DMN/SRMA



Localisation du champ de contrainte

Objectif : Obtenir la distribution du champ de contrainte local fonction de :

La phase

L'orientation cristalline du grain de la phase

De la texture du matériau

Du comportement mécanique du matériau

Du voisinage (via EF seulement)

Plusieurs échelles d'hétérogénéité :

Contraintes d'ordre 0 : Σ_{Macro}	Diffraction de Neutrons	
Contraintes d'ordre 1 : $<\sigma>_{Ferrite}$, $<\sigma>_{Cementite}$	Modélisation Polycristalline	
Contraintes d'ordre 2 : $<\sigma>_{< ijk > [hkl]}$	à champ moyen	
Contraintes d'ordre 3 : Hétérogénéité de $\sigma_{[hkl]}$	Simulation aux Elements	Finis



PLAN



Localisation de la contrainte :

- . Expérimentale
- . Polycristalline
- . Eléments finis

Loi de Comportement

- □ Résultats Analyse
- Conclusion Perspectives



DMN/SRMA

Loi de comportement cristalline

Développée dans le cadre de la thèse ECP/CEA de M. Libert [Libert, 2007].

Loi d'écoulement [Louchet et al., 1979] :





Loi d'écrouissage [Rauch, 1993] :

$$\tau^s = \tau_0 + \tau^s_{e\!f\!f} + \tau^s_\mu$$

$$\tau_{eff}^{s}$$
: contrainte effective
 τ_{μ}^{s} : contrainte athermique

$$\tau^{s}_{\mu} = \frac{(\mu b)^2 \sum_{u} a^{su} \rho^{u}}{\tau^{s} - \tau_0}$$

Loi d'évolution de ρ^{s} [Essman & Mughrabi, Mecking 1979, & Kocks 1981, Estrin & Mecking 1983]:

26 Novembre 2009 Hétérogénéité de déformation dans les polycristaux



Configuration isocline relachée [Mandel, 1973]

Fe

Premier et second principe de la thermodynamique :

Fp

Loi d'état :
$$\underline{\underline{S}} = \underline{\underline{C}}^{e} : \underline{\underline{E}}^{e}$$
 avec $\underbrace{\underline{\underline{S}}}_{\underline{\underline{F}}} = J \underline{\underline{F}}^{e^{-1}} \underline{\underline{\underline{G}}} \underline{\underline{F}}^{e^{-T}} = \frac{\rho_{0}}{\rho} \underline{\underline{F}}^{e^{-1}} \underline{\underline{\underline{G}}} \underline{\underline{F}}^{e^{-T}}$
 $\underline{\underline{\underline{F}}}^{e} = \frac{1}{2} \left(\underline{\underline{\underline{F}}}^{e^{T}} \underline{\underline{F}}^{e} - \underline{\underline{I}} \right)$

Lois d'évolution pour γ^s et ρ^s vues p. précédente avec

$$\tau^{s} = \underline{\underline{\Sigma}} : \underline{\underline{N}}^{s} = \left(\underline{\underline{F}}^{eT} \underline{\underline{F}}^{e} \underline{\underline{E}}^{e} \underline{\underline{E}}^{e}\right) : \left(\underline{\underline{m}}^{s} \otimes \underline{\underline{n}}^{s}\right)$$
[Cailletaud,

2008]:

26 Novembre 2009



Loi de comportement cristalline

Implantation numérique implicite. Variables $\underline{E}^{e}, \Delta \gamma^{s}, \Delta r^{s}$



$$\begin{split} & = \underbrace{\underline{E}^{*} - \underline{\underline{E}}^{e} - \left\{ \underbrace{\underline{N}^{s} \underbrace{\underline{C}}^{e}}_{\equiv} \right\} \Delta \gamma^{s} = 0} \\ & \Delta \gamma^{s} - \dot{\gamma}_{0} \exp\left[- \frac{\Delta G(\tau_{eff}^{s})}{k_{B}T} \right] signe(\tau^{s}) \Delta t = 0 \\ & \Delta r^{s} - b\left(\frac{1}{\Lambda^{s}} - \frac{g_{c}(T)}{b} r^{s} \right) \Delta \gamma^{s} = 0 \end{split}$$

avec
$$\underline{\underline{E}}^* = \frac{1}{2} (\underline{\underline{F}}^{*T} \underline{\underline{F}}^* - \underline{\underline{I}})$$
 où $\underline{\underline{F}}^* = \underline{\underline{F}}_{n+1} \underline{\underline{F}}_n^p$
une déformation d'essai

Difficultés liées à un pas de déformation important : A la première itération, $\underline{\Delta E} = \underline{\Delta E}^e$ et si $\left\| \underline{\Delta E}^e \right\|$ est trop importante, $\Delta \gamma^s$ n'est plus définie \longrightarrow On stocke pas à pas $R_n^{\Delta E} = \frac{\left\| \underline{\Delta E}_n^e \right\|}{\left\| \underline{\Delta E}_n \right\|}$ et $\underline{\dot{E}}_n^e = \frac{dE_n^e}{dt}$ Pour proposer un meilleur jeu de valeurs initiales A la première itération, $\underline{\Delta E}_{n+1}^e = \underline{\dot{E}}_n^e \Delta t$ ou en cas de difficulté dans la minimisation de $\underline{\Delta E}_{n+1}^e = R_n^{\Delta E} \underline{\Delta E}_{n+1}$

Enfin, si la première mesure de résidu est trop importante, redécoupage du pas de temps au sein de l'Umat



Loi de comportement cristalline

Choix des variables de minimisation $\underline{\underline{E}}^{e}, \Delta \gamma^{s}, \Delta r^{s}$ $\underline{\underline{E}}^{e} - \underline{\underline{E}}^{e} - \left\{ \underline{\underline{N}}^{s} \underbrace{\underline{C}}^{e} \right\} \Delta \gamma^{s} = 0$ $\Delta \gamma^{s} - \dot{\gamma}_{o} exp \left[-\frac{\Delta G(\tau_{eff}^{s})}{k_{B}T} \right] signe(\tau^{s}) \Delta t = 0$ $\Delta r^{s} - b \left(\frac{1}{A^{s}} - \frac{g_{e}(T)}{b} r^{s} \right) \Delta \gamma^{s} = 0$ $\frac{\underline{\underline{E}}^{e}}{k_{B}} + \Delta \gamma^{s} \underline{\underline{N}}^{s} \quad \text{et} \quad \underline{\underline{F}}^{e}_{n+1} = \underline{\underline{F}}_{n+1} \underline{\underline{F}}_{n+1}^{p^{-1}} \text{ mais alors} \quad \underline{\underline{E}}^{e}_{n+1} \neq \frac{1}{2} \left(\underline{\underline{F}}_{n+1}^{e^{-T}} \underline{\underline{F}}_{n+1}^{e^{-1}} - \underline{\underline{I}} \right)$

Du coup, on retire \underline{E}^{e} de la liste des variables libres dans le processus de minimisation

$$\begin{cases} \Delta \gamma^{s} - \dot{\gamma}_{0} \exp\left[-\frac{\Delta G\left(\tau_{eff}^{s}\right)}{k_{B}T}\right] signe(\tau^{s}) \Delta t = 0\\ \Delta r^{s} - b\left(\frac{1}{\Lambda^{s}} - \frac{g_{c}(T)}{b}r^{s}\right) \Delta \gamma^{s} = 0\end{cases}$$

Avec pour valeurs initiales, le résultat du processus de minimisation précédent après quelques itérations

On obtient :
$$\gamma_{n+1}^{s}, r_{n+1}^{s}$$
 puis

$$\frac{\underline{F}_{n+1}^{p} = \underline{F}_{n}^{p} + \Delta \gamma^{s} \underline{N}^{s}}{\underline{F}_{n+1}^{e} = \underline{F}_{n+1} \underline{F}_{n+1}^{p} \overset{-1}{\text{et}} \underline{E}_{n+1}^{e} = \frac{1}{2} \left(\underline{F}_{n+1}^{e} \underline{F}_{n+1}^{e} - \underline{I} \right) \underbrace{\underline{\sigma}}_{n+1} = \frac{1}{J} \underline{F}_{n+1}^{e} \underline{S}_{n+1} \underline{F}_{n+1}^{e} \overset{T}{\underline{F}}_{n+1}^{e} - \underline{I}$$



Loi de comportement cristalline

DMN/SRMA



Application au cas d'une traction sur monocristal glissement double :





PLAN



Localisation de la contrainte :

- . Expérimentale
- . Polycristalline
- . Eléments finis
- Loi de Comportement
- Résultats Analyse
- Conclusion Perspectives







Effet de maillage : Réponse d'1 orientation sur un seul calcul





Résultats par phase





Résultats par phase





Hétérogénéité de déformation dans les polycristaux

26 Novembre 2009



Dispersion par phase





Condition de propagation d'un défaut de taille un paquet de latte bainitique

$$K_{IC} \approx \sqrt{E\Gamma_s}$$
 puis $\sigma_R \approx \frac{K_{IC}}{\sqrt{\alpha a}}$ avec a $\approx 10\mu$ m
 $P_R(V_0) = 1 - P(\sigma_{001} < \sigma_R) = 1 - \exp\left(-\left(\frac{\sigma_R - \langle \sigma_I \rangle}{B}\right)\right)$

À comparer avec un modèle plus classique type Beremin



BILAN / Perspectives

Implantation numérique d'une loi de comportement cristalline en grandes transformations (intégration implicite, $\Delta \epsilon \approx 1\%$)

Application d'une méthode de localisation numérique par éléments finis. Résultats en accord qualitatif avec :

- . Des données expérimentales
- . Une modélisation polycristalline

Utilisation des distributions de contrainte de clivage pour alimenter un modèle d'approche locale de la rupture fragile

Difficultés rencontrées :

Temps de calcul et taille de microstructure

Pour (30 grains, 2,3 10⁵ ddl, 10⁵ Pts Gauss) ε =10% \approx 1 jour sur bipro dualcore







Localisation par EF

DMN/SRMA Calculs sur microstructures. Réponses macro et par phase.

Conditions aux limites Nombre de grains

Influence de :



Maillage (type et nombre d'éléments)





œ

Bilan de l'implantation numérique implicite :

La procédure décrite permet de réaliser des calculs sur un élément de volume avec des pas de déformation de plusieurs pourcents

temps de calcul optimal pour des pas de l'ordre du pourcent.

Mise en évidence d'un effet du type d'élément fini sur des simulations de traction d'une poutre monocristalline



Résultats par phase





Résultats par phase

